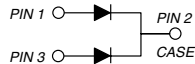
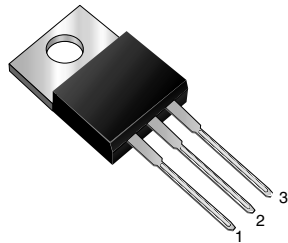


TMBS®
TO-220AB

FEATURES

- Trench MOS Schottky technology
- Lower power losses, high efficiency
- Low forward voltage drop
- High forward surge capability
- High frequency operation
- Solder bath temperature 275 °C maximum, 10 s, per JESD 22-B106
- Compliant to RoHS directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC


RoHS
COMPLIANT

TYPICAL APPLICATIONS

For use in high frequency rectifier of switching mode power supplies, freewheeling diodes, dc-to-dc converters or polarity protection application

PRIMARY CHARACTERISTICS

$I_{F(AV)}$	2 x 5.0 A
V_{RRM}	90 V, 100 V
I_{FSM}	120 A
V_F	0.75 V
T_J max.	150 °C

MECHANICAL DATA
Case: TO-220AB

Molding compound meets UL 94 V-0 flammability rating

Base P/N-E3 - RoHS compliant, commercial grade

Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 and JESD 22-B102

E3 suffix meets JESD 201 class 1A whisker test

Polarity: As marked

Mounting Torque: 10 in-lbs maximum

MAXIMUM RATINGS ($T_C = 25\text{ °C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	90	100	V
Working peak reverse voltage	V_{RWM}	90	100	V
Maximum DC blocking voltage	V_{DC}	90	100	V
Maximum average forward rectified current at $T_C = 105\text{ °C}$ total device per diode	$I_{F(AV)}$	10 5.0		A
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	I_{FSM}	120		A
Non-repetitive avalanche energy at $T_J = 25\text{ °C}$, $L = 60\text{ mH}$ per diode	E_{AS}	60		mJ
Peak repetitive reverse current at $t_p = 2\text{ }\mu\text{s}$, 1 kHz, $T_J = 38\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ per diode	I_{RRM}	0.5		A
Voltage rate of change (rated V_R)	dV/dt	10 000		V/ μs
Operating junction and storage temperature range	T_J, T_{STG}	- 65 to + 150		°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T _C = 25 °C unless otherwise noted)						
PARAMETER	TEST CONDITIONS		SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Maximum instantaneous forward voltage per diode ⁽¹⁾	I _F = 5.0 A I _F = 5.0 A	T _C = 125 °C T _C = 25 °C	V _F	0.75 0.85		V
Maximum reverse current per diode at working peak reverse voltage ⁽²⁾		T _J = 25 °C T _J = 100 °C	I _R	100 6.0		μA mA

Notes

⁽¹⁾ Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle

⁽²⁾ Pulse test: Pulse width $\leq 40\text{ ms}$

THERMAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)				
PARAMETER	SYMBOL	MBR1090CT	MBR10100CT	UNIT
Typical thermal resistance per diode	$R_{\theta JC}$	4.4		$^{\circ}\text{C/W}$

ORDERING INFORMATION (Example)					
PACKAGE	PREFERRED P/N	UNIT WEIGHT (g)	PACKAGE CODE	BASE QUANTITY	DELIVERY MODE
TO-220AB	MBR10100CT-E3/4W	1.87	4W	50/tube	Tube

RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

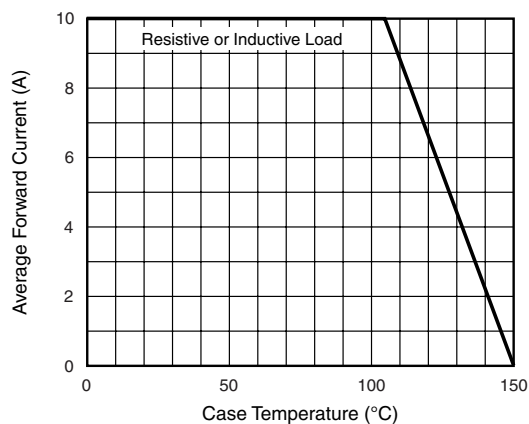


Figure 1. Forward Current Derating Curve

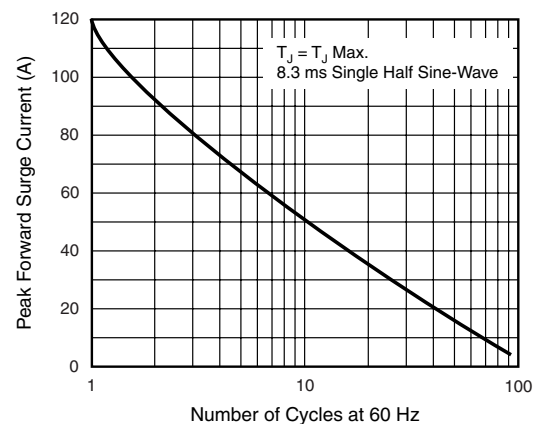


Figure 2. Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Per Diode



KERSEMI

MBR1090CT, MBR10100CT

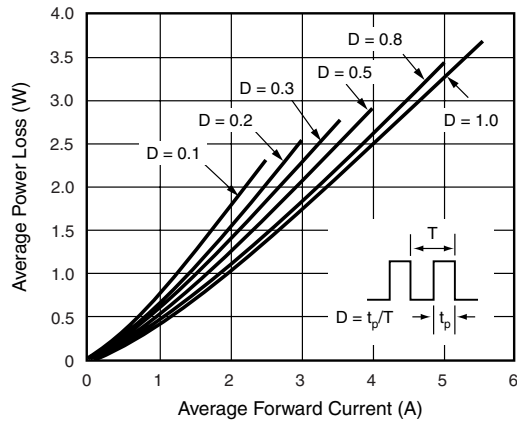


Figure 3. Forward Power Loss Characteristics Per Diode

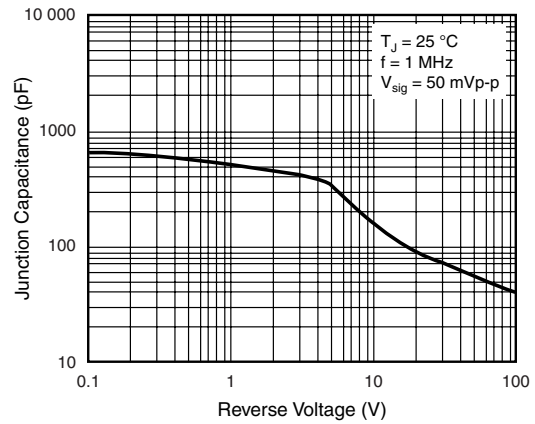


Figure 6. Typical Junction Capacitance Per Diode

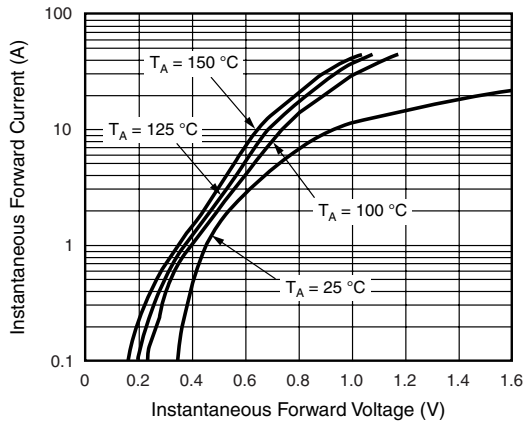


Figure 4. Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode

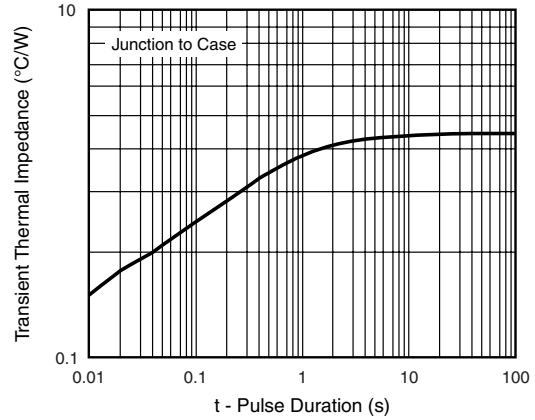


Figure 7. Typical Transient Thermal Impedance Per Diode

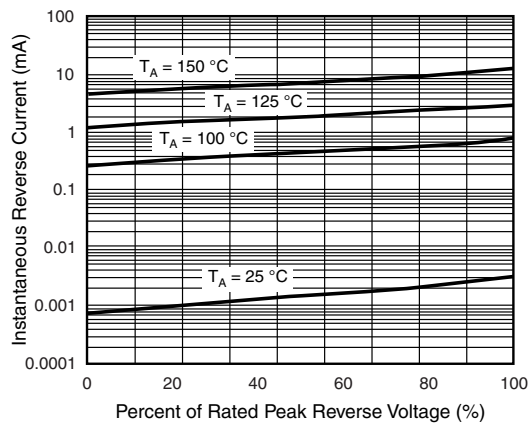
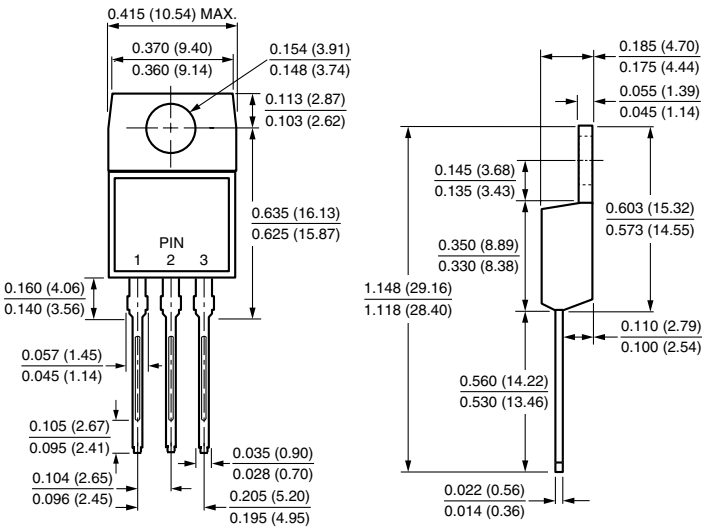


Figure 5. Typical Reverse Characteristics Per Diode

PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)

TO-220AB



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9